

トランジスタ

T-33-09

2SC2594

2SC2594

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

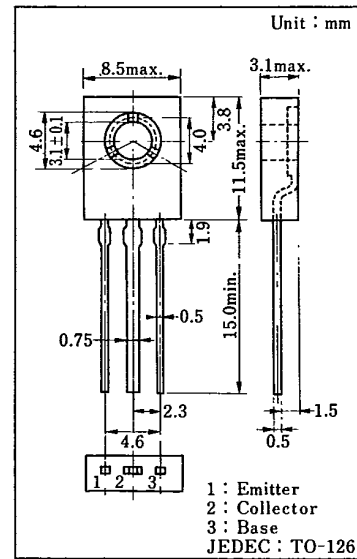
低周波電力増幅用 / AF Power Amplifier
 ストロボ用 / For Electronic Flash Unit
 コンバータ用 / Converter

■ 特徴 / Features

- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。 / Low $V_{CE(sat)}$
- 高効率で低電圧電源での動作特性がよい。 / High performance at low supply voltage.

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	40	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	20	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	8	A
コレクタ電流	I_C	5	A
コレクタ損失 (Tc = 25 °C)	P_C	10	W
接合部温度	T_J	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 10 V, I_E = 0$			0.1	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 7 V, I_C = 0$			0.1	μA
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 1 mA, I_B = 0$	20			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = 10 \mu A, I_C = 0$	7			V
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = 2 V, I_C = 0.5 A^*$	140		450	
	h_{FE2}	$V_{CE} = 2 V, I_C = 1 A^*$	70			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 3 A, I_B = 0.1 A$			1	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = 6 V, -I_E = 50 mA$		150		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 20 V, I_E = 0, f = 1 MHz$			50	pF

* パルス測定 / Pulse Test

トランジスタ

T-33-09

2SC2594

